



1) powierzchnia aktywna równoległa, 2) powierzchnia aktywna osiowo, 3) Strefa wolna, 4) patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu



## Basic features

Dopuszczenie / Zgodność	CE WEEE
EN 55011	Wlk.1,kl.A
EN 55022	Gr.1,kl.B
Kształt anteny	Pręt
Zasada działania	Nośnik danych

## Electrical data

Cykle odczytu	bez ograniczeń
Cykle programowania	≥ 100.000
Czas odczytu	do 4 bajtów: 0.18 s
Czas programowania	do 4 bajtów: 0.305s
Czas przechowywania danych / lata	≥ 10
Organizacja pamięci	48 × 4 bits

## Environmental conditions

Ciągłe obciążenie udarowe	tak
EN 60068-2-27 szok	tak
EN 60068-2-32 Swobodny upadek	tak
EN 60068-2-6 wibracja	tak
Stopień ochrony	IP68, 1 m, 24 h, 20 °C
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Temperatura składowania, tymczasowa	-40...90 °C 1x1000 h

## Functional Characteristics

Numer seryjny UID, tylko do odczytu	4 Byte
Pamięć użytkownika, odczyt/zapis	192 Byte
Typ pamięci	EEPROM

## Material

Materiał obudowy	Szkło, Przezroczysty
------------------	----------------------

## Mechanical data

Masa	0.22 g
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Wymiary	Ø 3.15 x 13.3 mm

LF (125 kHz)  
**BIS L-150-05/A**  
Kod artykułu: BIS003N

**BALLUFF**

#### Remarks

---

Przy montażu w metalu: pamiętać o strefie wolnej.  
Jeśli nie podano inaczej, wartości dot. warunków znamionowych.  
Możliwość zastosowania tylko z głowicami zapisu/odczytu od wersji HW 2.0.  
Tylko w połączeniu z przewidzianą głowicą zapisu/odczytu.  
Obciążenia skrętne, zginające i udarowe są niedopuszczalne.  
Warunki zastosowania patrz odpowiednia głowica zapisu/odczytu.  
Informacja o czasie w tym kontrola danych.